

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-097470

(43)Date of publication of application : 09.04.1999

(51)Int.Cl.

H01L 21/56
 B29C 33/38
 H01L 21/60
 H01L 23/12
 // B29L 31:34

(21)Application number : 09-250799

(71)Applicant : ROHM CO LTD

(22)Date of filing : 16.09.1997

(72)Inventor : YOSHIDA KENJI

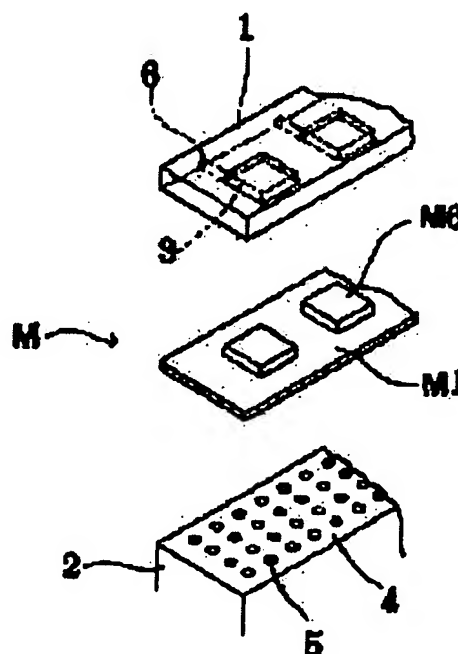
(54) MOLDING DIE STRUCTURE OF BGA SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent resin flashes from attaching, by forming a recessed part in a compression surface of a lower mold used for molding of a BGA semiconductor device, and arranging the recessed part in a position which is relevant to a place wherein a solder ball is provided to project.

SOLUTION: A recessed part 5 is formed in a lower mold 2 which is compressed to a rear of a substrate. When a mold process on a substrate is finished, molds 1, 2 are released from a substrate M1 to separate a chip on a substrate. In the process, there is a possibility that resin flash drops on the lower mold 2 during releasing and attaches thereto.

However, since the recessed part 5 is formed in a compression surface of the lower mold 2, resin flash fits in the recessed part 5 in a position corresponding to a gold plating part during compression of the lower mold 2 and resin flash does not attach to a gold plating part of the substrate M1. As a result, solder ball welding can be surely carried out and it is possible to eliminate the cause to chip a solder ball due to resin burr which lies between a gold plating part and a solder ball.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-97470

(43) 公開日 平成11年(1999)4月9日

(51) Int. Cl. ⁴	識別記号	P I	
H 0 1 L 21/58		H 0 1 L 21/58	R D
B 2 9 C 33/38		B 2 9 C 33/38	
H 0 1 L 21/60	3 1 1	H 0 1 L 21/60	3 1 1 S
23/12		23/12	L

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 4 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平8-250799

(22) 出願日 平成9年(1997)9月16日

(71) 出願人 000116024

ローム株式会社

京都府京都市右京区西院藤崎町21番地

(72) 発明者 吉田 賢司

福岡県行橋市大字額直字白ケ田837番地の

1 ローム福岡株式会社内

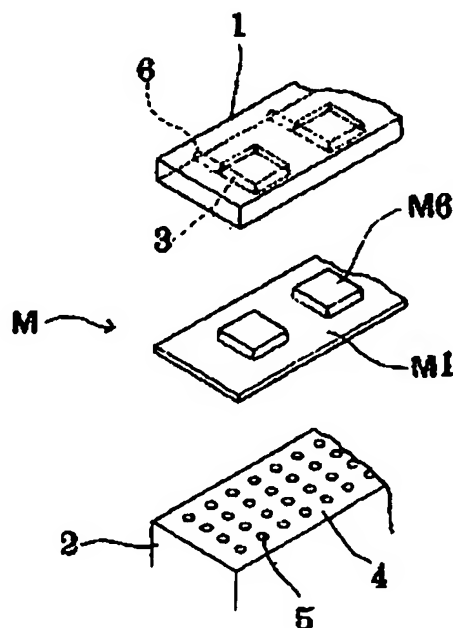
(74) 代理人 弁理士 松尾 重一郎

(54) 【発明の名称】 BGA型半導体装置のモールド用金型構造

(57) 【要約】

【課題】 この発明は、BGA型半導体装置のモールド用金型の構造に関する。

【解決手段】 この発明は、BGA型半導体装置のモールド成型を行う際に用いるモールド下型の圧着面に、凹部を形成すると共に凹部は半田ボールが突設されるべき位置と相応する箇所に配置してなるBGA型半導体装置のモールド用金型の構造を提供せんとするものである。



(2)

特開平11-97470

1

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 BGA型半導体装置のモールド成型を行う際に用いるモールド下型の圧着面に、凹部を形成すると共に凹部は半田ボールが突設されるべき位置と相応する個所に配置してなるBGA型半導体装置のモールド用金型の構造。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、BGA型半導体装置のモールド用金型構造に関する。

【0002】

【従来の技術】BGA型半導体装置は、基板上にチップを載置固定し、基板裏面に半田ボールを突設し、チップは樹脂でモールドされている。

【0003】かかる半導体装置のモールド成型に際しては、図3、図4に示すようにモールド上型1とモールド下型2との間にチップ載置の基板Mを介在させてモールド成型をする。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】ところが、モールド時に生起する樹脂バリnが、図3に示すようにモールド下型2上に付着していると、次の製品のモールド成型時に、図5に示すように基板M裏面に形成された半田ボールM4のスルーホール導通体である金メッキ部M5に樹脂バリnが圧着されることになる。かかる状態で次工程の、半田ボールM4のリフロー工程を経ると、半田ボールM4が樹脂バリnによって金メッキ部M5に固着し溶着されないことになり、半田ボールM4の欠落する原因となるおそれがあった。

【0005】

【課題を解決するための手段】この発明は、BGA型半導体装置のモールド成型を行う際に用いるモールド下型の圧着面に、凹部を形成すると共に凹部は半田ボールが突設されるべき位置と相応する個所に配置してなるBGA型半導体装置のモールド用金型の構造を提供せんとするものである。

【0006】

【発明の実施の形態】この発明では、BGA型半導体装置のモールド成型を行う際に用いるモールド下型の圧着面に凹部を形成し、凹部は半田ボールが突設されるべき位置と相応する個所に配置されている。

【0007】従って、モールド成型時に樹脂バリが生じ船型時に樹脂バリがモールド下型の圧着面に付着しても次の製品のモールド工程時には、樹脂バリはモールド下型の凹部に収容されており、従って、少なくともBGA型半導体装置の基板の半田ボール位置と相対する個所すなわち凹部位置では、樹脂バリがモールド下型と基板裏面との間に圧着されるおそれはない。

【0008】もっとも、凹部位置以外の部分では、樹脂バリの圧着が生起してもその部分は半田ボールが突設さ

れる部分ではないので、半田ボールの溶着には全く影響がない。

【0009】従って、半田ボールが突設されるべき位置であるプリントされた金メッキ部には樹脂バリが付着しないため、後工程での半田ボールの溶着が確実に行なえる。

【0010】

【実施例】この発明の実施例を図面にもとづき詳説する。

10 【0011】図1、図2に示すのは、本発明のモールド用金型構造を示す実施例である。

【0012】MはBGA型半導体装置を示しており、同装置Mは、図6に示すようにガラスエポキシ樹脂等で成形された基板M1上にチップM2を載置固定し、ワイヤーM3をボンディングして、基板M1裏面に突設した半田ボールM4とチップM2とを導通状態として構成されている。

【0013】かかるBGA型半導体装置Mの製造工程中のモールド工程は、基板M1上に固定し、ワイヤーボンディングをしたチップM2を樹脂モールドM6する。

【0014】樹脂モールドする作業工程は、図1、図2に示すように、モールド上型1とモールド下型2との間に、モールド対象のチップ付基板Mを介在し、上下から圧着し樹脂を注入して、樹脂モールドする。

【0015】モールド上型1には、基板M1上面をモールドするための型凹部3が下面に形成されており、型凹部3に注入路6を介して樹脂を注入して基板上をモールドする（図1）。

【0016】他方、モールド下型2の基板圧着面4には樹脂バリnが収納される凹部5が形成されており、しかも、この凹部5は、モールド工程後に行われる半田ボールM4のリフロー工程時に、半田ボールM4が突設されるべき位置に相応する個所に配置されている。

【0017】すなわち、図6に示すように、基板M1の裏面には、チップM2と導通する半田ボールM4が突設されるものであるが、半田ボールM4を突設すべき位置には、図2中の反転図に示すようにチップM2と導通すべく、ボンディングワイヤーM3と導通した金メッキ部M5が印刷されており、この金メッキ部M5の相対位置に凹部5が形成されていることになる。

40 【0018】凹部5の形状は、図1に示すように半田ボールM4の突設位置にある金メッキ部M5と対応した円形くぼみとしたものと、図2に示すように基板圧着面4上に縦方向及び横方向の多数の条溝7、7'を形成し、その交差部分に金メッキ部M5が位置する凹部5を形成するようになったもの等がある。

【0019】このように、基板の裏面に圧着されるモールド下型2に凹部5を形成することにより、次のような作用効果が生起する。

【0020】すなわち、基板上のモールド工程が完了するとモールド上下型1、2は基板上のチップを船型すべ

(3)

特開平11-97470

く基板M1から能反する。

【0021】この際、脱型時に樹脂バリnがモールド下型2上に落下し、付着する場合が生起する。

【0022】このまま、次製品のモールド工程のために新しい基板がモールド上下型1、2間に搬送されてきて上下型1、2が基板M1を圧着モールドすると、モールド下型2上の樹脂バリn、基板M1の裏面、すなわち半田ボールM4の突設位置の金メッキ部M5に付着し、モールド工程の後の半田ボールのリフロー工程時に、半田ボールM4と金メッキ部M5との溶着が阻害される。

【0023】しかし、モールド下型2の圧着面に凹部5が形成されているため、樹脂バリnは、該下型2の圧着時に、金メッキ部M5に対応する位置において凹部5中に嵌入し、少なくとも図3、図4、図5に示すような基板M1の金メッキ部M5に樹脂バリnが付着する状態となることはない。

【0024】

【発明の効果】この発明によれば、モールド下型の圧着面に凹部を形成し、凹部は半田ボールが突設されるべき位置と相応する箇所に配置しているため、モールド成型時や脱型時に生起する樹脂バリが、金型の作動時に、モールド下型の圧着面に付着しても、樹脂バリは凹部に収納される。

【0025】従って、モールド下型と基板とが圧着されても半田ボールが突設される金メッキ部には樹脂バリが付着せず、後工程での半田ボール溶着が確実に進み、従来

* 来の金メッキ部と半田ボールとの間に樹脂バリが介在して半田ボールの欠陥が生起する原因を除去できる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明構造の斜視説明図。

【図2】他の実施例の斜視説明図。

【図3】従来技術の斜視説明図。

【図4】従来技術のモールド成型の断面説明図。

【図5】同要部の拡大断面図。

10 【図6】GBA型半導体装置の断面説明図。

【符号の説明】

M BGA型半導体装置

M1 基板

M2 チップ

M3 ワイヤボンディング

M4 半田ボール

M5 樹脂モールド

n 樹脂バリ

1 上型

2 下型

3 型凹部

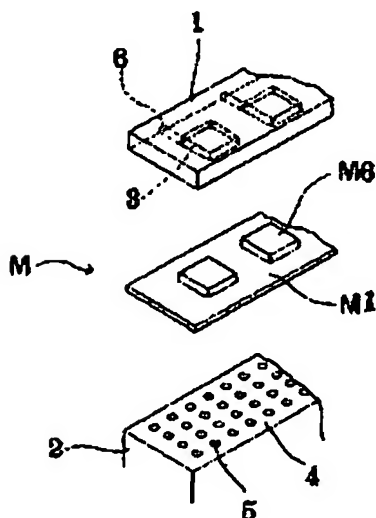
4 圧着面

5 凹部

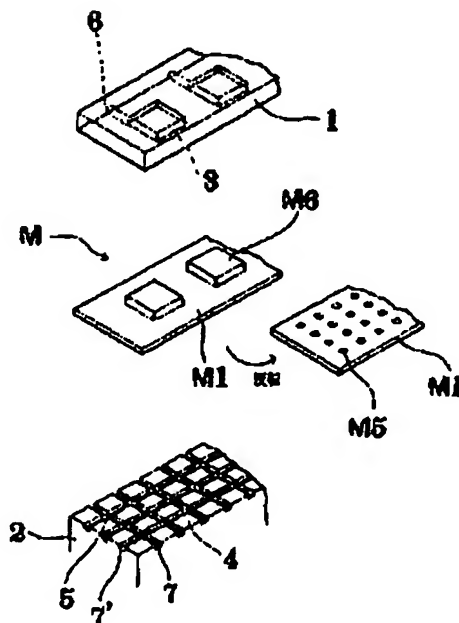
7 条溝

7' 条溝

【図1】



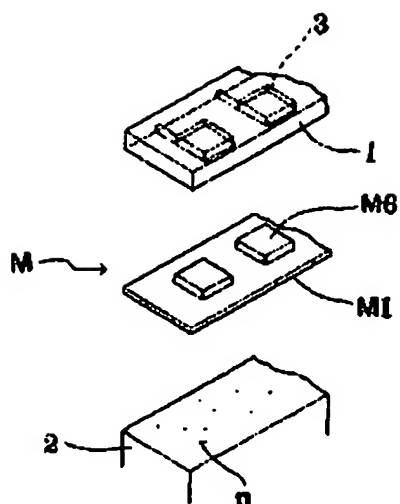
【図2】



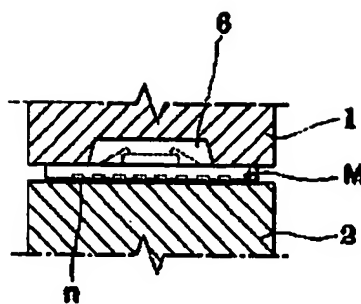
(4)

特開平11-97470

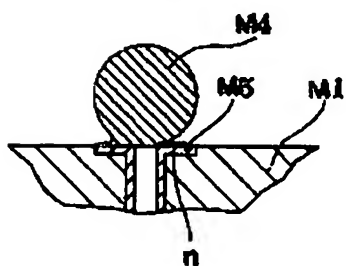
【図3】



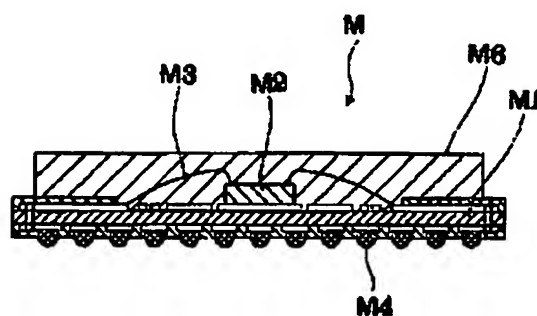
【図4】



【図5】



【図6】



フロントページの続き

(51)Int. Cl.⁸

識別記号

F I

// B 2 9 L 31:34